

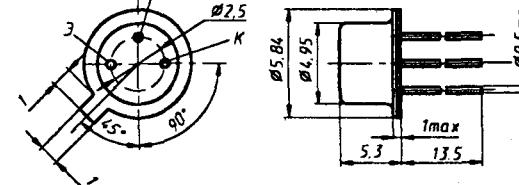
**КТ3102Г, КТ3102Е, КТ3102Ж, КТ3102И, КТ3102К,  
КТ3102ГМ, КТ3102ЕМ, КТ3102ЖМ, КТ3102ИМ,  
КТ3102КМ**

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры *p-n-p* универсальные. Предназначены для применения в низкочастотных устройствах с малым уровнем шумов, переключающих, усилительных и генераторных устройствах средней и высокой частоты. Выпускаются: КТ3102(Г-К) в металлокерамическом корпусе с гибкими выводами, тип прибора указывается на корпусе, КТ3102(ГМ-КМ) в пластмассовом корпусе с гибкими выводами, на торце корпуса наносится метка: КТ3102ГМ — голубая, КТ3102ЕМ — белая, КТ3102ЖМ — две темно-красные, КТ3102ИМ — две желтые, КТ3102КМ — две темно-зеленые. Тип прибора указывается в этикетке.

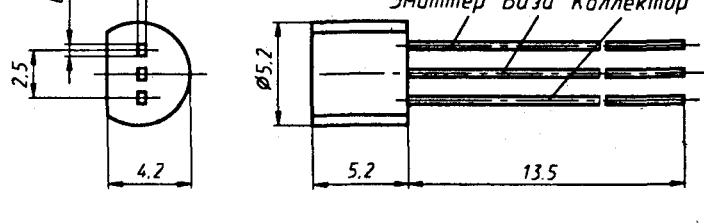
Масса транзистора в металлокерамическом корпусе не более 0,5 г, в пластмассовом корпусе не более 0,3 г.

Изготовители — акционерное общество открытого типа «Элекс», г. Александров, Владимирская область, акционерное общество «Светланка», г. Санкт-Петербург, акционерное общество «Кремний», г. Брянск, Нальчикский завод полупроводниковых приборов, г. Нальчик.

КТ3102(Г, Е, Ж, И, К)



КТ3102(ГМ, ЕМ, ЖМ, ИМ, КМ)



### Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока  
в схеме ОЭ при  $U_{KB} = 5$  В,  $I_S = 2$  мА:

$T = +25$  °C:

КТ3102Ж, КТ3102ЖМ .....	100...250
КТ3102И, КТ3102К, КТ3102ИМ,	
КТ3102КМ .....	200...500
КТ3102Г, КТ3102Е, КТ3102ГМ,	
КТ3102ЕМ .....	400...1000

$T = -40$  °C:

КТ3102Ж, КТ3102ЖМ .....	25...250
КТ3102И, КТ3102К, КТ3102ИМ,	
КТ3102КМ .....	50...500

КТ3102Г, КТ3102Е, КТ3102ГМ,	
КТ3102ЕМ .....	100...1000

$T = +85$  °C, не менее:

КТ3102Ж, КТ3102ЖМ .....	100
КТ3102И, КТ3102К, КТ3102ИМ,	
КТ3102КМ .....	200
КТ3102Г, КТ3102Е, КТ3102ГМ,	
КТ3102ЕМ .....	400

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при  $U_{KB} = 5$  В,  $I_S = 10$  мА, не менее:

КТ3102Г, КТ3102Е, КТ3102ГМ, КТ3102ЕМ..	150 МГц
КТ3102Ж, КТ3102И, КТ3102К, КТ3102ЖМ,	
КТ3102ИМ, КТ3102КМ .....	200 МГц

Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте при  $U_{KB} = 5$  В,  $I_S = 10$  мА,  $f = 30$  МГц, не более .....

100 пс

Коэффициент шума на  $f = 1$  кГц при  $U_{KB} = 5$  В,  $I_K = 0,2$  мА,  $R_f = 2$  кОм:

КТ3102Г, КТ3102ГМ, не более .....	10 дБ
типовое значение .....	5 дБ
КТ3102ЕМ, не более .....	4 дБ
типовое значение .....	2,5* дБ

Граничное напряжение при  $I_S = 10$  мА, не менее:

КТ3102Ж, КТ3102И, КТ3102ЖМ,	
КТ3102ИМ .....	30 В
КТ3102К, КТ3102КМ .....	25 В
КТ3102Г, КТ3102Е, КТ3102ГМ, КТ3102ЕМ..	15 В

Обратный ток коллектора-эмиттера

при  $U_{KB} = U_{KB, MAX}$ , не более:

КТ3102Ж, КТ3102И, КТ3102ЖМ,	
КТ3102ИМ .....	0,1 мкА
КТ3102Г, КТ3102Е, КТ3102К, КТ3102ГМ,	
КТ3102ЕМ, КТ3102КМ .....	0,05 мкА

Обратный ток коллектора при  $U_{KB} = U_{KB, MAX}$ ,

не более:

$T = +25$ °C:	
КТ3102Ж, КТ3102И, КТ3102ЖМ,	

КТ3102ИМ .....	0,1 мкА
$T = +85$ °C .....	5 мкА

Обратный ток эмиттера при  $U_{KB} = 5$  В,

не более..... 10 мкА

Емкость коллекторного перехода

при  $U_{KB} = 5$  В, не более ..... 6 пФ

# Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—база:

KT3102Ж, KT3102И, KT3102ЖМ,	50 В
KT3102ИМ .....	30 В
KT3102К, KT3102КМ .....	20 В

Постоянное напряжение коллектор—эмиттер:

KT3102Ж, KT3102И, KT3102ЖМ,	50 В
KT3102ИМ .....	30 В
KT3102К, KT3102КМ .....	20 В

KT3102Г, KT3102Е, KT3102ГМ, KT3102ЕМ..	20 В
--	------

Постоянное напряжение эмиттер—база..... 5 В

Постоянный ток коллектора .....

Импульсный ток коллектора при  $t_i = 40 \text{ мкс}$ ,

$Q = 500$  .....

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора<sup>1</sup> при  $T = -40\ldots+25^\circ\text{C}$  .....

Тепловое сопротивление переход—среда.....

Температура  $p-n$  перехода .....

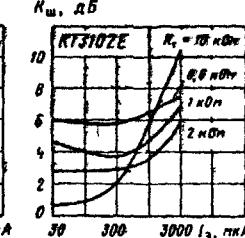
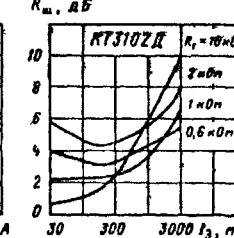
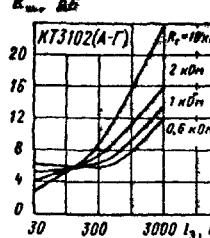
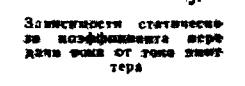
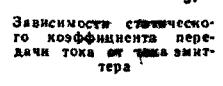
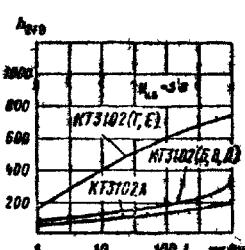
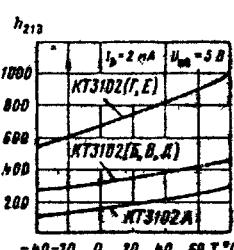
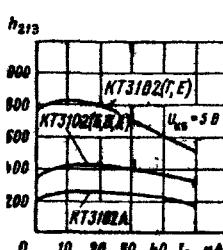
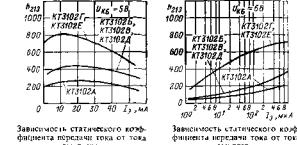
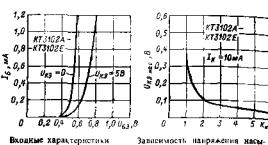
Температура окружающей среды .....

<sup>1</sup> При  $T > +25^\circ\text{C}$  максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора рассчитывается по формуле

$$P_{\text{х макс}} = (125 - T)/0,4, \text{ мВт.}$$

Пайка выводов допускается не ближе 5 мм от корпуса транзистора в течение не более 3 с, температура пайки не выше  $+260^\circ\text{C}$ .

Допускается использование транзисторов в инверсном включении.



Зависимости коэффициента шума от тока эмиттера

Зависимости коэффициента шума от тока эмиттера

Зависимости коэффициента шума от тока эмиттера